

2025年1月22日(水)

| 開始時間 | 終了時間 | 時間 | 内容 | タイトル | 所属 | 講演者 |
|-------|-------|------|---------|---------------------|------|--------|
| 19:00 | 20:30 | 1:30 | チュートリアル | まだまだ奥深いALD（原子層堆積）技術 | NIMS | 生田目 俊秀 |

2025年1月23日(木)

| 開始時間 | 終了時間 | 時間 | 内容 | タイトル | 所属 | 講演者 |
|---------------------------|-------|------|---------|---|--------|--------|
| 9:00 | 9:10 | 0:10 | Opening | 開会のあいさつ | | |
| 1 基調講演I | | | | | | |
| 9:10 | 10:00 | 0:50 | 基調講演 | NANDフラッシュメモリの開発経緯及び次世代メモリに期待すること | 国立精華大学 | 白田 理一郎 |
| 10:00 | 10:20 | 0:20 | 休憩 | | | |
| 2 メモリ・表面・薄膜 | | | | | | |
| 10:20 | 10:50 | 0:30 | 招待講演 | 高速メモリ応用を見据えたChannel-All-Around型強誘電体トランジスタの動作実証 | キオクシア | 株柳 翔一 |
| 10:50 | 11:10 | 0:20 | 一般講演 | オゾンを用いたプリア酸化及びポスト酸化によるAl ₂ O ₃ /Ge MOS界面の研究 | 千葉大学 | 高橋 大輝 |
| 11:10 | 11:30 | 0:20 | 一般講演 | ALD-GeO ₂ 界面層を用いたGeSn/Ge pnダイオードの表面パッシベーション | 名古屋大学 | 加藤 芳規 |
| 11:30 | 11:50 | 0:20 | 一般講演 | WSe ₂ 上のALD実現に向けたUV-O ₃ 暴露と真空アニールによる最表面へのSe欠陥導入 | 千葉大学 | 小島 拓也 |
| 11:50 | 12:10 | 0:20 | 一般講演 | 高導電性Ceドープ水素化酸化インジウム(ICO:H)薄膜の開発 | 産総研 | 工藤 晃哉 |
| 12:10 | 13:30 | 1:20 | 休憩 | | | |
| P ポスターセッション | | | | | | |
| 13:30 | 15:10 | 1:40 | ポスター | | | |
| 15:10 | 15:20 | 0:10 | 休憩 | | | |
| 3 基調講演II | | | | | | |
| 15:20 | 16:10 | 0:50 | 基調講演 | ダイヤモンド量子センサの可能性 | 東京科学大学 | 波多野 睦子 |
| 16:10 | 16:40 | 0:30 | 休憩/写真撮影 | | | |
| 4 量子コンピュータ・SiC・GaN | | | | | | |
| 16:40 | 17:10 | 0:30 | 招待講演 | ノイズ耐性を向上するConcatenated Continuous Drivingを用いたシリコン量子ビット操作技術 | 日立製作所 | 久野 拓馬 |
| 17:10 | 17:30 | 0:20 | 一般講演 | 第一原理計算を用いた4H-SiC中の基底面転位(BPD)拡張メカニズムの解明 | 名古屋大学 | 佐野 雅季 |
| 17:30 | 17:50 | 0:20 | 一般講演 | 第一原理計算を用いたNOアニール後のSiC(1-100)/SiO ₂ 界面の電子状態解析 | 神戸大学 | 杉山 耕生 |
| 17:50 | 18:10 | 0:20 | 一般講演 | GaNエピタキシャル成長におけるMg不純物取り込み機構の解析 | 名古屋大学 | 大木 淳平 |
| 18:10 | 18:30 | 0:20 | 休憩 | | | |
| 交流会 | | | | | | |
| 18:30 | 20:10 | 1:40 | 交流会 | | | |

2025年1月24日(金)

| 開始時間 | 終了時間 | 時間 | 内容 | タイトル | 所属 | 講演者 |
|---------------------------|-------|------|---------|--|------------|--------|
| 8:55 | 9:00 | 0:05 | 2日目案内 | | | |
| 5 薄膜・デバイス | | | | | | |
| 9:00 | 9:30 | 0:30 | 招待講演 | CSD法を用いた機能性酸化物薄膜及びデバイス応用に関する検討 | 村田製作所 | 宮迫 毅明 |
| 9:30 | 9:50 | 0:20 | 一般講演 | 高性能多結晶Ge薄膜トランジスタに向けた低温粒界制御成長 | 筑波大学 | 居倉 功汰 |
| 9:50 | 10:10 | 0:20 | 休憩 | | | |
| 6 企画セッション | | | | | | |
| 10:10 | 12:10 | 2:00 | 企画セッション | 最先端半導体デバイスの開発動向 | | |
| | | | | 先端ロジックデバイスの開発動向：2nmからBeyond 2nmへ | 東京大学 | 平本 俊郎 |
| | | | | 2D FETの研究状況や応用へ向けた課題 | 東京科学大学 | 若林 整 |
| | | | | 車載パワーデバイスの技術動向とその課題 | 豊田中央研究所 | 山下 侑佑 |
| | | | | 最新3Dフラッシュメモリ技術動向と将来展望 | キオクシア | 大内 和也 |
| 12:10 | 13:30 | 1:20 | 昼食 | | | |
| 7 理論・エネルギーハーベスティング | | | | | | |
| 13:30 | 14:00 | 0:30 | 招待講演 | 第一原理量子論で見るシリコンテクノロジー | 名古屋大学 | 白石 賢二 |
| 14:00 | 14:20 | 0:20 | 一般講演 | キャパシティ付き集積熱電デバイスの微細化効果 | 早稲田大学 | 三浦 拓也 |
| 14:20 | 14:40 | 0:20 | 一般講演 | マイクロ集積熱電デバイスの熱電レグ部に印可される温度差の特定 | 早稲田大学 | 荒山 瀧一朗 |
| 14:40 | 15:00 | 0:20 | 一般講演 | アルカリ金属で作製されるアモルファスSiO ₂ 薄膜エレクトレットの第一原理計算による帯電状態評価 | 名古屋大学 | 桐越 大貴 |
| 15:00 | 15:20 | 0:20 | 休憩 | | | |
| 8 Si表面・MOS界面 | | | | | | |
| 15:20 | 15:50 | 0:30 | 招待講演 | CMOSイメージセンサの特性向上に寄与する新たな機能性シリコンウエーハの研究 | SUMCO | 奥山 亮輔 |
| 15:50 | 16:20 | 0:30 | 招待講演 | シリコン酸化膜のためのReaxFF開発と原子レベルプロセス評価 | 日本サムスン | 野秋 淳一 |
| 16:20 | 16:40 | 0:20 | 一般講演 | レーザー角度分解光電子分光法を用いたホールサブバンドの高分解能測定 | 東レリサーチセンター | 坂田 智裕 |
| 16:40 | 16:50 | 0:10 | 休憩 | | | |
| 表彰式・閉会式 | | | | | | |
| 16:50 | 17:10 | 0:20 | Closing | 表彰式など | | |

| ポスターセッション | ID | タイトル | 所属 | 講演者 |
|---|-----|--|--------|-------|
| 1月23日 13:30-15:10 | P01 | 4H-SiC表面近傍に誘起した炭素欠陥の高温水素雰囲気による低減効果 | 東京大学 | 呂 楚陽 |
| コアタイム IDが奇数の講演者 前半(13:30-14:20) IDが偶数の講演者 後半(14:20-15:10) | P02 | 4H-SiC表面に対するNラジカル窒化とNOアニール窒化の表面N密度飽和挙動を決定する因子の違い | 東京大学 | 吉田 遥希 |
| | P03 | 電子線照射により生成したSiO ₂ /Si界面欠陥分布の評価 | 筑波大学 | 清水 峻央 |
| | P04 | 実験室系HAXPESによる不純物濃度の異なる基板を用いたMOS構造の電圧印加特性評価 | 明治大学 | 箕輪 卓哉 |
| | P05 | エッチング溶液中C-V測定によるSiO ₂ 膜中固定電荷分布評価 | 筑波大学 | 渡部 智也 |
| | P06 | MOSFET極低温動作におけるバンド端準位の影響：mk帯SS温度依存性の定量的理論検討 | 東京理科大学 | 小林 唯華 |
| | P07 | 200nmSOI-MOSFETの極低温での正方向の基板バイアス依存性 -極低温でのみ発生するBox界面でのトラップ現象- | 金沢工業大学 | 李 龍聖 |
| | P08 | ALD酸化剤へのH ₂ O ₂ の適用によるHf _{0.5} Zr _{0.5} O ₂ 薄膜の低温結晶化の促進 | 東京大学 | 車 浩銘 |
| | P09 | Hf _{0.5} Zr _{0.5} O ₂ を用いたMFMキャパシタの電気的特性の温度変化 | 愛知工業大学 | 手島 蒼生 |
| | P10 | トンネルFET用Ti _{0.3} Zn _{0.7} O _{1.3} チャネルの電子物性に対して界面形成プロセスが与える影響 | 明治大学 | 小川 健太 |
| | P11 | SiH ₄ 照射による極薄Ni膜のシリサイド化反応制御 | 名古屋大学 | 谷田 駿 |
| | P12 | 成長したGeS薄膜における複屈折効果の観察 | NIMS | 張 秦強 |
| | P13 | CVD単層MoS ₂ を用いたMISキャパシタにおけるCV特性評価 | 千葉大学 | 中村 志穂 |
| | P14 | 二次元半導体材料の界面準位密度評価手法 | 筑波大学 | 佐藤 優 |
| | P15 | グラフェン/スマネン/グラフェン積層構造の抵抗変化現象 | 東京都市大学 | 川合 遼一 |
| | P16 | F6-TCNNQ単分子層成膜によるWSe ₂ 上へのALD成膜評価 | 千葉大学 | 松田 健生 |